



中华人民共和国国家标准

GB/T 36474—2018

半导体集成电路 第三代双倍数据速率同步动态随机 存储器(DDR3 SDRAM)测试方法

Semiconductor integrated circuit—
Measuring methods for double data rate 3 synchronous dynamic random access
memory (DDR3 SDRAM)

2018-06-07 发布

2019-01-01 实施



国家市场监督管理总局
中国国家标准化管理委员会

发布

目 次

前言	III
1 范围	1
2 规范性引用文件	1
3 术语和定义	1
4 一般要求	2
4.1 通则	2
4.2 功能验证的一般要求	2
4.3 电参数测试的测试向量	2
4.4 电参数测试的示波器	2
4.5 测试环境	2
5 详细要求	3
5.1 功能验证	3
5.2 时钟	3
5.3 读数据参数	6
5.4 写数据参数	8
5.5 电源电流(I_{DD})/数据管脚的电源电流(I_{DDQ})	11

前 言

本标准按照 GB/T 1.1—2009 给出的规则起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别这些专利的责任。

本标准由中华人民共和国工业和信息化部提出。

本标准由全国半导体器件标准化技术委员会(SAC/TC 78)归口。

本标准起草单位:中国电子技术标准化研究院、西安紫光国芯半导体有限公司、上海高性能集成电路设计中心、武汉芯动科技有限公司、成都华微电子科技有限公司。

本标准主要起草人:孔宪伟、殷梦迪、尹萍、巨鹏锦、高专、刘建明。